Elettromagnetismo

Prof. Francesco Ragusa Università degli Studi di Milano

Lezione n. 11 - 4.11.2022

Campo di un anello di carica
Capacità, condensatori
Energia del condensatore
Forza fra le armature del condensatore

Anno Accademico 2022/2023

Cariche immagine e energia

- Un ultimo problema per chiarire un altro un punto importante
 - ullet Quanto lavoro è necessario per portare una carica q dall'infinito a distanza h da un piano conduttore?
 - Per rispondere uno studente (o un professore ...) ragiona in questo modo:
 - Abbiamo visto che la forza è quella che si esercita fra la carica e la sua immagine a^2

 $F = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 \left(2h\right)^2}$

• Analogamente il lavoro calcolato, cambiato di segno, è uguale all'energia elettrostatica immagazzinata nel sistema carica + carica immagine

$$U = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 \left(2h\right)}$$

- Un altro studente (o professore ...) preferisce un calcolo meno elegante, più di "forza bruta"
 - Calcola il lavoro fatto contro la forza elettrostatica
 - Ad una altezza z avremo

$$dW = Fdz = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 \left(2z\right)^2} dz$$

Cariche immagine

• Il lavoro totale si trova integrando

$$W = \frac{q^2}{4 \cdot 4\pi\varepsilon_0} \int_{h}^{\infty} \frac{1}{z^2} dz = \frac{q^2}{4 \cdot 4\pi\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{z} \right]_{h}^{\infty} = \frac{q^2}{4 \cdot 4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{h} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2h}$$

- Il valore trovato è la metà di quello trovato con il primo calcolo
- Chi ha ragione e perché?
- Il risultato corretto è il secondo

$$W = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{2h}$$

- Nel primo caso infatti manca il vincolo su come costruire il sistema
 - Occorre spostare le due cariche in modo simmetrico rispetto al piano altrimenti il campo elettrico non è più perpendicolare al piano
 - Se spostiamo entrambe le cariche il lavoro da considerare è solo metà: quello fatto per spostare solo una delle due cariche

$$U = \int_{V} \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 dV$$

- $\begin{array}{ll} \bullet \text{ Alternativamente si può ricordare che} & U = \int_V \frac{\varepsilon_0}{2} E^2 dV \\ \bullet \text{ La formula} & U = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0\left(2h\right)} & \text{Presuppone un integrale su tutto lo spazio} \\ \end{array}$
 - Nella nostra soluzione il campo è definito solo in metà dello spazio

ullet Consideriamo nuovamente l'anello di carica Q e di raggio R

• L'anello è rappresentabile con una distribuzione lineare di carica di densità $\lambda = Q/(2\pi R)$





- ullet La lunghezza dell'elemento è $dl=R\ d\phi'$
- ullet La carica dell'elemento è $dQ=\lambda dl$
- ullet Chiamiamo il potenziale $V({f r})$ per evitare confusione con l'angolo azimutale ϕ
- ullet Il contributo al potenziale dell'elemento di anello dl ullet

$$dV(\mathbf{r}) = \frac{dQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{s} = \frac{\lambda R d\phi'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\left|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\right|} = \frac{\lambda R d\phi'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{\mathbf{r}^2 + \mathbf{r}'^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}'}}$$

$$dV(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R d\phi'}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2r\sin\theta R\cos(\phi' - \phi)}}$$

• Nell'ultima espressione abbiamo sviluppato il prodotto scalare fra ${f r}$ e ${f r}'$ tenendo conto che ${f r}'$ giace nel piano x-y $(r'_z=0)$

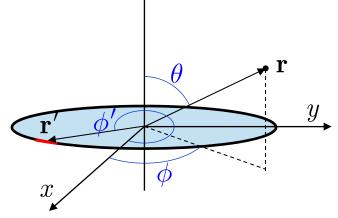
ullet Verifichiamo calcolando il prodotto scalare esplicitamente z

$$\mathbf{r} = r \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \phi \\ \sin \theta \sin \phi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \qquad \mathbf{r}' = R \begin{pmatrix} \cos \phi' \\ \sin \phi' \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r}' = R \begin{pmatrix} \cos \phi' \\ \sin \phi' \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' = rR \sin \theta (\cos \phi \cos \phi' + \sin \phi \sin \phi')$$

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}' = rR \sin \theta \cos(\phi' - \phi)$$



• Il potenziale generato da tutto l'anello è

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi'}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2r\sin\theta R\cos(\phi' - \phi)}}$$

- ullet evidente che l'integrale non dipende da ϕ (simmetria azimutale)
- Possiamo porre $\phi = 0$

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi'}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2r\sin\theta R\cos\phi'}}$$

- È un integrale che non conduce a espressioni contenenti funzioni elementari
 - Richiede l'introduzione degli integrali ellittici

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{d\phi}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2r\sin\theta R\cos\phi}}$$

- Trasformiamo l'integrale in una forma opportuna rispetto alle definizioni standard degli integrali ellittici
 - ullet Prima di tutto operiamo un cambio di variabile: $\phi=\pi+2t$
 - I limiti di integrazione diventano

$$ullet$$
 $\phi=0
ightarrow t=-\pi/2 \qquad \phi=2\pi
ightarrow t=+\pi/2$. Inoltre $d\phi=2dt$

- ullet La funzione trigonometrica: $\cos\phi=\cos(\pi+2t)=-\cos2t=-1+2\sin^2t$
- Chiamiamo A il radicando

$$A = r^2 + R^2 - 2r\sin\theta R\cos\phi = r^2 + R^2 + 2r\sin\theta R - 4r\sin\theta R\sin^2t$$

Definiamo

$$\xi^2 = r^2 + R^2 + 2r\sin\theta R$$

finiamo
$$\xi^2 = r^2 + R^2 + 2r\sin\theta R \qquad \qquad k^2 = \frac{4Rr\sin\theta}{r^2 + R^2 + 2r\sin\theta R}$$

Otteniamo

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R}{4\pi\varepsilon_0 \xi} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{+\frac{\pi}{2}} \frac{2dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}} = \frac{\lambda R}{\pi\varepsilon_0 \xi} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}}$$

ullet Osserviamo che per $\overset{2}{0} \leq heta \leq \pi$ e $0 \leq r < \infty$ abbiamo $0 \leq k \leq 1$

$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R}{\pi \varepsilon_0 \xi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}}$$

$$\xi^2 = r^2 + R^2 + 2r \sin \theta R$$

$$k^2 = \frac{4Rr \sin \theta}{r^2 + R^2 + 2r \sin \theta R}$$

$$\xi^{2} = r^{2} + R^{2} + 2r\sin\theta R$$

$$k^{2} = \frac{4Rr\sin\theta}{r^{2} + R^{2} + 2r\sin\theta R}$$

• Si definisce integrale ellittico completo di primo tipo

$$K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 t}}$$

- Per la definizione e le proprietà degli integrali ellittici si veda
 - NIST Digital Library of Mathematical Functions capitolo 19 https://dlmf.nist.gov/ $\rho = \frac{\tau}{R}$
- Introduciamo la variabile ridotta ρ
 - In funzione di ρ il parametro k è

$$k^2 = \frac{4\rho\sin\theta}{1 + \rho^2 + 2\rho\sin\theta}$$

Infine

$$\frac{\xi^2}{R^2} = 1 + \rho^2 + 2\rho\sin\theta$$

Integrali ellittici

- ullet Per il calcolo del campo elettrico $\dot{f e}$ necessaria la derivata della funzione K(k)
 - Vedi NIST DLMF 19.4

$$\frac{dK(k)}{dk} = \frac{E(k) - (1 - k^2)K(k)}{k(1 - k^2)}$$

ullet La funzione E(k) è l'integrale ellittico completo di secondo tipo

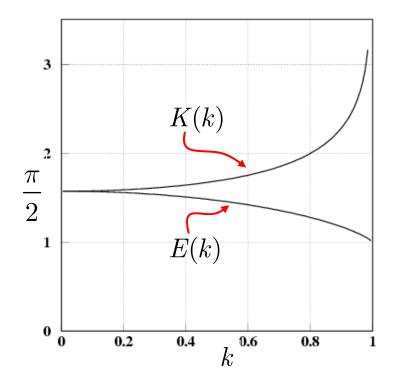
$$E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 t} \, dt$$

Notiamo infine che

$$K(0) = E(0) = \frac{\pi}{2}$$

$$E(1) = 1$$

$$\lim_{k \to 1} K(k) = \infty$$



• Calcoliamo il valore del potenziale al centro dell'anello

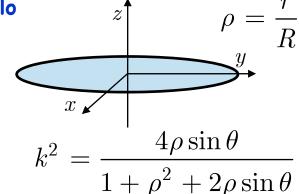
$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R}{\pi \varepsilon_0 \xi} K(k)$$

• Al centro dell'anello $\pi arepsilon_0 \xi$

$$\rho = 0 \qquad k = 0 \qquad \frac{\xi}{R} = 1$$

Abbiamo pertanto

$$V(0) = \frac{\lambda R}{\pi \varepsilon_0 \xi} K(0) = \frac{\lambda}{\pi \varepsilon_0} \frac{\pi}{2} = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0}$$



$$\frac{\xi^2}{R^2} = 1 + \rho^2 + 2\rho\sin\theta$$

• A grandi distanze dal centro dell'anello

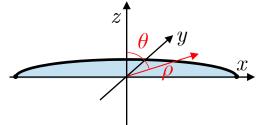
$$ho \to \infty \qquad k \to 0 \qquad \frac{\xi^2}{R^2} \to \rho^2 \qquad \frac{\xi}{R} \to \frac{r}{R} \qquad \xi \to r$$

Abbiamo pertanto

$$\lim_{r\to\infty}V(\mathbf{r})\to\frac{\lambda R}{\pi\varepsilon_0r}K(0)=\frac{\lambda R}{\pi\varepsilon_0r}\frac{\pi}{2}=\frac{\lambda R}{\pi\varepsilon_0r}\frac{2\pi}{2\cdot 2}=\frac{2\pi R\lambda}{4\pi\varepsilon_0r}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r}$$

• A grandi distanze è il potenziale della carica dell'anello posta nell'origine

- Visualizziamo il potenziale con alcuni grafici
 - ullet Consideriamo il potenziale nel piano y=0
 - Una sezione x-z
 - Normalizziamo il potenziale al suo valore nel centro dell'anello



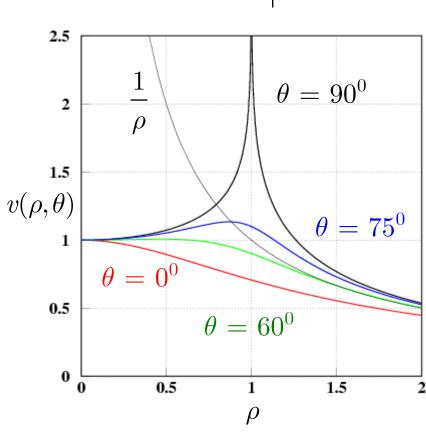
$$V(\mathbf{r}) = \frac{\lambda R}{\pi \varepsilon_0 \xi} K(k) \qquad V(0) = \frac{\lambda}{2\varepsilon_0}$$

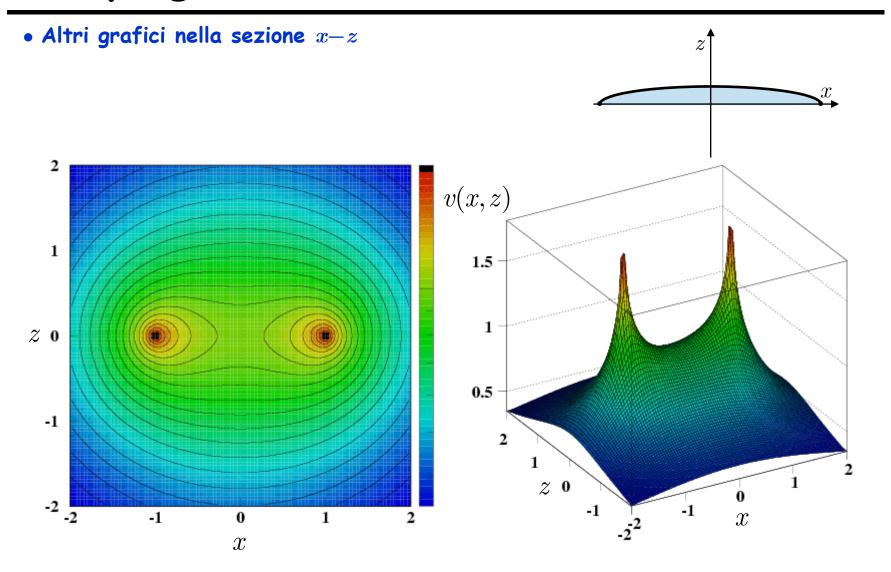
$$v(\mathbf{r}) = \frac{V(\mathbf{r})}{V(0)} = \frac{2}{\pi} \frac{R}{\xi} K(k)$$

$$\rho = \frac{r}{R} = \frac{\sqrt{x^2 + z^2}}{R}$$

$$k^2 = \frac{4\rho\sin\theta}{1 + \rho^2 + 2\rho\sin\theta}$$

$$\frac{\xi^2}{R^2} = 1 + \rho^2 + 2\rho\sin\theta$$





Capacità di un conduttore

- Consideriamo un conduttore isolato
 - Ad esempio una sfera
- ullet Supponiamo che sul conduttore sia depositata una certa quantità di carica q
 - ullet La carica si distribuisce sulla superficie del conduttore con una densità superficiale σ



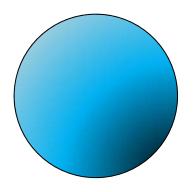




$$q = \oint_{S} \sigma(x', y', z') da' \qquad \phi(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \oint_{S} \frac{\sigma(x', y', z')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} da' \qquad \mathbf{r}' = (x', y', z')$$

- ullet Se il punto ${f r}$ si muove sulla superficie del conduttore il potenziale assumerà sempre lo stesso valore $V=\phi({f r})$
 - La superficie del conduttore è equipotenziale
- ullet Supponiamo adesso di variare la densità di carica sul conduttore $\sigma
 ightarrow k \; \sigma$
 - ullet Anche la quantità di carica sarà moltiplicata per $k: q o k \ q$
 - ullet Anche il potenziale sul conduttore sarà moltiplicato per $k: V o k \ V$

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \oint_S \frac{k\sigma\left(x',y',z'\right)}{\left|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right|} da' = \frac{k}{4\pi\varepsilon_0} \oint_S \frac{\sigma\left(x',y',z'\right)}{\left|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\right|} da' = k\phi\left(x,y,z\right)$$



Capacità di un conduttore

- Ne consegue che il rapporto fra la carica sul conduttore e il potenziale della superficie è indipendente dal valore della carica
 - Questo rapporto dipende dalla geometria del conduttore e prende il nome di capacità del conduttore

$$C = \frac{q}{V}$$

- Dipende anche dal mezzo che circonda il conduttore
- Per adesso supponiamo che sia il vuoto
- L'unità di misura della capacità (Coulomb/Volt) è il Farad
 - Vedremo che un Farad è una capacità enorme e quindi normalmente si usano dei sottomultipli

• milliFarad	$10^{-3}~\mathrm{F}$	$\mathbf{m}\mathbf{F}$
• microFarad	$10^{-6}~\mathrm{F}$	$\mu {f F}$
• nanoFarad	$10^{-9}~\mathrm{F}$	\mathbf{nF}
• picoFarad	$10^{-12} \; { m F}$	\mathbf{pF}
• femtoFarad	$10^{-15} \; \mathrm{F}$	fF

- ullet Calcoliamo la capacità di una sfera di raggio R
 - ullet Mettiamo una carica q sulla superficie della sfera e calcoliamo il potenziale sulla sua superficie

Capacità di un conduttore

- ullet Sappiamo che il potenziale sul conduttore è uguale a quello di una carica q posta al centro della sfera
 - Pertanto il potenziale sulla superficie sarà

• E la capacità

$$V = \phi(R) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R}$$

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{R}} = 4\pi\varepsilon_0 R \qquad \boxed{\varepsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}}$$

- ullet Come preannunciato dipende solo dalla geometria $(4\pi R)$
- ullet Notiamo che il prodotto $arepsilon_0 R$ ha le dimensioni del Farad
 - È abitudine (ed è anche comodo) utilizzare per le unità di ε_0 il F/m (Farad per metro)

$$\varepsilon_0 = 8.854 \text{ pF/m}$$

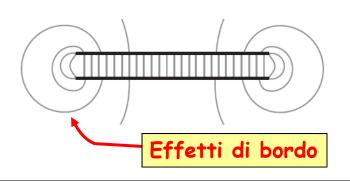
- Qualche esempio numerico
 - R = 0.1 m $\rightarrow C = 1.11 \times 10^{-11} \text{ F} = 11 \text{ pF}$
 - ullet $R=6700~{
 m Km}$ $ightarrow C=0.74 imes 10^{-3}~{
 m F}$ $=0.74~{
 m mF}$ (raggio della terra)
 - ullet $R=9 imes10^6$ Km ightarrow C = 1F (il sole dista 150 $imes10^6$ Km, la luna 0.4 $imes10^6$ Km)

Condensatore

- Il concetto di capacità è utile e importante anche per sistemi di più conduttori
 - Uno dei sistemi a più conduttori più diffusi e utilizzati è quello costituito da due conduttori: il condensatore
 - Studieremo in seguito i sistemi a più di due conduttori
- ullet Consideriamo un sistema composto da due conduttori piani di area A posti a distanza ravvicinata
 - I due conduttori prendono il nome di elettrodi o armature
 - ullet Supponiamo di depositare una carica +q sull'elettrodo superiore e una carica -q sull'elettrodo inferiore



- In queste condizioni possiamo approssimare il campo fra gli elettrodi come il campo fra due distribuzioni superficiali di carica uniforme e infinite
 - Una soluzione esatta del problema mostrerebbe una configurazione del campo elettrico come indicata in figura



Condensatore

- Trascuriamo gli effetti di bordo: il campo elettrico fra due piani di carica è uniforme e perpendicolare agli elettrodi (è nullo fuori)

• Il suo modulo è
$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \qquad \sigma=\frac{q}{A}$$
 Tutte le linee di campo che partono da un piano finiscono sull'altro.

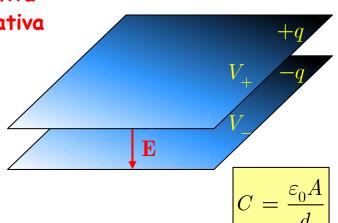
- A questo punto è immediato calcolare la differenza di potenziale fra gli elettrodi
 - ullet V_{+} il potenziale dell'elettrodo con la carica positiva
 - ullet V_- il potenziale dell'elettrodo con la carica negativa

$$V = V_{+} - V_{-} = -\int_{0}^{d} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -(-Ed) = Ed$$

ullet Introducendo i valori di E e di σ

$$V = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = \frac{q}{A\varepsilon_0} d$$

- Analogamente a quanto fatto per il conduttore singolo definiamo capacità del condensatore il rapporto fra la carica e il potenziale
 - Notiamo che ancora una volta dipende solo dalla geometria



Induzione completa

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{q}{A\varepsilon_0}d} = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

Condensatore

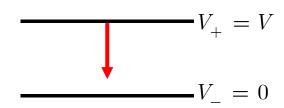
- Ci aspettiamo che il calcolo fatto sia tanto più accurato quanto più vicini sono i due piani
 - Nel caso in cui l'approssimazione non sia buona allora occorre calcolare esattamente la differenza di potenziale in funzione della carica
 - Troveremmo qualcosa di "leggermente" differente dalla formula trovata
- Sul libro di Purcell è riportato il risultato di un calcolo della capacità di un condensatore con armature circolari
 - La capacità calcolata esattamente viene confrontata con la formula approssimata

$$C = \frac{\varepsilon_0 \pi R^2}{s}$$

- ullet La tabella mostra il rapporto f fra la capacità esatta e quella approssimata in funzione di s/R
- Ribadiamo che due conduttori formano comunque un condensatore
 - Mantenere sotto controllo la geometria permette di costruire dispositivi utilizzati in circuiti elettronici
- Se la capacità è indesiderata si parla di effetto parassita

Energia immagazzinata nel condensatore

- I condensatori sono dispositivi utili perché possono immagazzinare (e conservare) energia
 - ullet Consideriamo un condensatore di capacità C
 - Consideriamo per semplicità l'elettrodo inferiore a potenziale nullo e quello superiore a potenziale V
 - ullet La carica sulle armature è (per definizione) $Q=C(V_{\scriptscriptstyle \perp}-V_{\scriptscriptstyle -})=CV$



$$Q = C(V_{\perp} - V_{-}) = CV$$

- ullet Supponiamo adesso di volere aumentare la carica sull'armatura superiore da qa q+dq trasportandola dall'elettrodo inferiore che passa da -q a -q-dq
 - Naturalmente è necessaria una forza non elettrostatica
 - Questa forza compie lavoro contro il campo elettrico per spostare una carica positiva dall'elettrodo inferiore a quello superiore
 - ullet Il lavoro fatto per trasportare dq $\dot{f e}$ dato semplicemente da

$$dW = Vdq$$
 $q = CV$ \longrightarrow $V = \frac{q}{C}$ $dW = \frac{q}{C}dq$

ullet Il lavoro totale per "caricare" un condensatore da 0 a Q è pertanto

$$W = \int_{0}^{Q} \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{C}$$

Energia immagazzinata nel condensatore

- ullet Il lavoro W è naturalmente uguale all'energia immagazzinata U=W
- Possiamo inoltre esprimere il risultato ottenuto in funzione della differenza di potenziale fra le armature de condensatore
 - Abbiamo infatti

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \qquad Q = CV \qquad \longrightarrow \qquad U = \frac{1}{2} \frac{\left(CV\right)^2}{C} \qquad \qquad U = \frac{1}{2} \frac{CV^2}{C}$$

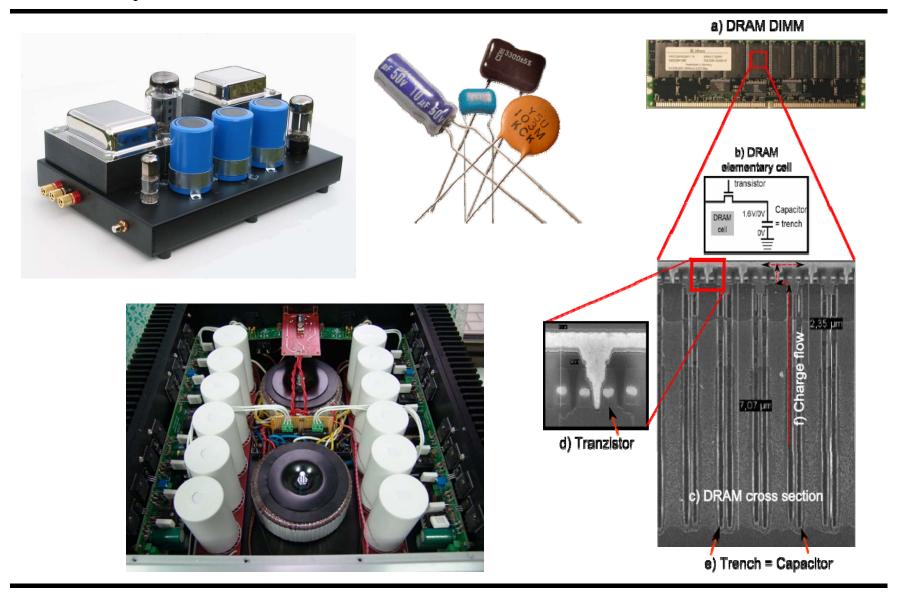
- L'energia trovata è naturalmente l'energia elettrostatica delle cariche sulle armature del condensatore
 - Tuttavia può essere interpretata come l'energia immagazzinata nel campo elettrostatico presente fra le armature del condensatore
 - In un condensatore piano, assumendo che possano essere trascurati gli effetti di bordo, il campo elettrico è uniforme
 - Il suo modulo è

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}\quad \text{La densità di energia} \quad \rho_E=\varepsilon_0\frac{E^2}{2}=\frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{\varepsilon_0}$$

ullet Moltiplicando per il volume Ad del condensatore

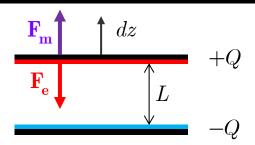
$$U = \rho_E A d = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0} A d = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0} \frac{A^2}{A} d = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\varepsilon_0} \frac{1}{A} d = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Esempi di condensatori



Forza fra le armature

- Consideriamo un condensatore carico sulle cui armature è presente una carica $\pm Q$
 - Le armature pertanto si attraggono
 - Naturalmente è presente una forza non elettrica che mantiene fissa la distanza L fra le armature



- Calcoliamo la forza con cui si attraggono
 - Iniziamo facendo il calcolo considerando il condensatore carico ma isolato da un eventuale generatore
 - La carica sulle armature è costante
- ullet Supponiamo di innalzare di un tratto dz l'armatura superiore
 - ullet Per farlo applichiamo una forza meccanica \mathbf{F}_{m} che bilancia esattamente la forza elettrica $\mathbf{F}_{\mathbf{e}}$
 - Il lavoro fatto dalla forza meccanica è $dW = \mathbf{F_m} \cdot d\mathbf{r} = F_{\mathrm{m}} dz = -F_{\mathrm{e}} dz$
- Se la distanza fra le armature aumenta l'energia immagazzinata aumenta

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \qquad \longrightarrow \qquad dU = \frac{1}{2} Q^2 d \frac{1}{C}$$

Infatti la capacità diminuisce

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{L} \longrightarrow \frac{1}{C} = \frac{L}{\varepsilon_0 A} \longrightarrow d\frac{1}{C} = \frac{dz}{\varepsilon_0 A} = \frac{L}{\varepsilon_0 A} \frac{dz}{L} = \frac{1}{C} \frac{dz}{L} \qquad dU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \frac{dz}{L}$$

$$dU = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \frac{dz}{L}$$

Forza fra le armature

$$dW = -F_{\rm e}dz$$
 $dU = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\frac{dz}{L}$

- Naturalmente l'aumento di energia è uguale al lavoro fatto dalla forza meccanica
 - Uguagliando

$$-F_{\rm e}dz = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \frac{dz}{L}$$

$$F_{\rm e} = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \frac{1}{L}$$

 $-F_{\rm e}dz = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\frac{dz}{L} \qquad \qquad \boxed{F_{\rm e} = -\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\frac{1}{L}} \qquad \qquad \text{diretta verso il basso} \\ \text{le armature si attraggono}$

- Calcoliamo adesso la forza nel caso in cui la differenza di potenziale fra le armature sia costante
 - Un approccio superficiale porterebbe a un risultato errato
- Utilizzando l'approccio precedente l'energia del condensatore sarebbe

$$U = \frac{1}{2}CV^2 \implies dU = \frac{1}{2}V^2dC$$

$$U = \frac{1}{2}CV^2 \longrightarrow dU = \frac{1}{2}V^2dC \qquad C = \frac{\varepsilon_0 A}{L} \longrightarrow dC = -\frac{\varepsilon_0 A}{L}\frac{dz}{L} = -C\frac{dz}{L}$$

Uguagliando

$$-F_{\rm e}dz = -\frac{1}{2}V^2C\frac{dz}{L}$$

$$-F_{\rm e}dz = -\frac{1}{2}V^2C\frac{dz}{L} \qquad F_{\rm e} = \frac{1}{2}V^2C\frac{1}{L} = \frac{1}{2}V^2C^2\frac{1}{C}\frac{1}{L} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}\frac{1}{L}$$

Ha il segno opposto !! SBAGLIATO

Forza fra le armature

- Naturalmente non è possibile che scollegando (o collegando) il condensatore a un generatore la forza cambi segno
 - ullet L'errore sta nel non aver considerato tutto il lavoro fatto per allontanare l'armatura di dz
 - Infatti se vogliamo mantenere costante la tensione dobbiamo far variare la carica sulle armature
 - ullet Se la capacità cambia di dC (positivo o negativo) la carica sulle armature deve cambiare di conseguenza: dQ=VdC
 - ullet Per trasportare una carica dQ sulle armature il generatore G compie un lavoro

$$dW_C = VdQ = V^2dC$$

• Il bilancio energetico corretto è pertanto

$$dW_{\rm m} + dW_G = dU \longrightarrow -F_{\rm e}dz + V^2dC = \frac{1}{2}V^2dC$$

$$-F_{\rm e}dz = -\frac{1}{2}V^2dC$$

Ricordiamo che

$$dC = -C\frac{dz}{L} \longrightarrow -F_{e}dz = \frac{1}{2}CV^{2}\frac{dz}{L} = \frac{1}{2}\frac{Q^{2}}{C}\frac{dz}{L} \qquad F_{e} = -\frac{1}{2}\frac{Q^{2}}{C}\frac{1}{L}$$

In accordo con il primo calcolo